

ISSN 1813-8586

НАНО-И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА



- Нанотехнологии
- Зондовая микроскопия
- Микромашины и наносистемы
- Молекулярная электроника
- Биоактивные нанотехнологии
- Элементы датчиков и биочипы
- Микроэлектромеханические системы
- Микрооптоэлектромеханические системы
- Биомикроэлектромеханические системы

6 (155)
2013

Рисунки к статье И. А. Аверина, И. А. Губича
 «Исследование процессов рекристаллизации алюминиевой фольги –
 стадии получения пористого оксида алюминия»

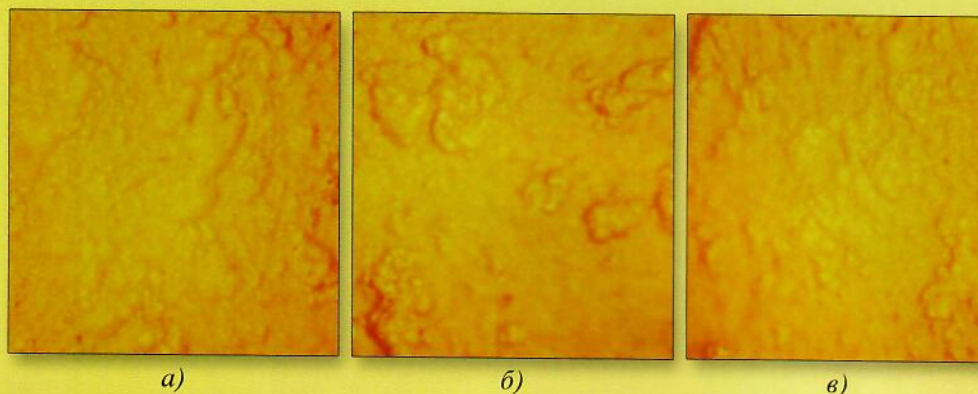


Рис. 2. Фотоснимки поверхности алюминиевой фольги, полученные на оптическом микроскопе, при изменении температуры и постоянном времени отжига: а – 100°C; б – 300°C; в – 600°C

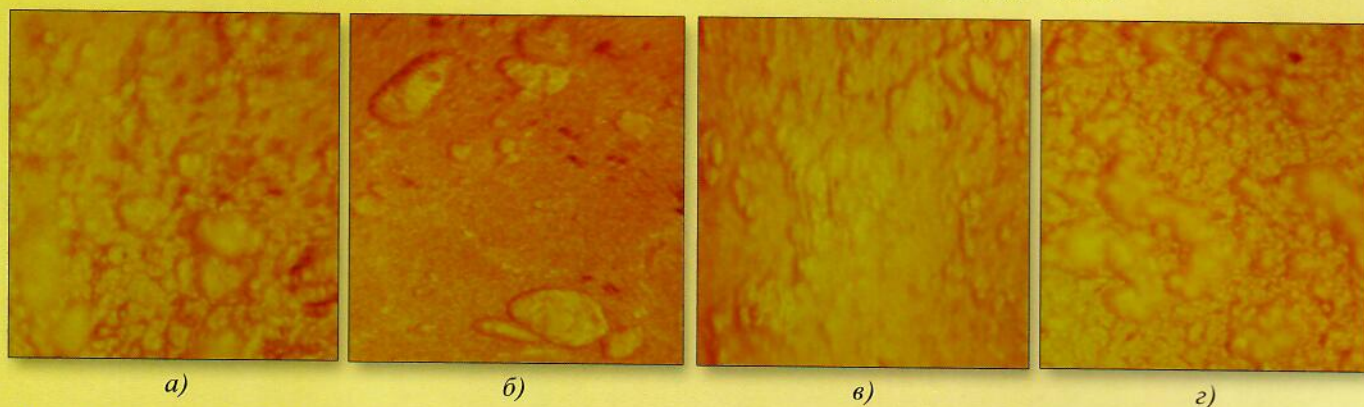


Рис. 3. Фотоснимки ОМ поверхности алюминиевой фольги, полученные при изменении времени отжига и постоянной температуре: а – не отожженная алюминиевая фольга; б – 1 ч; в – 3 ч; г – 6 ч

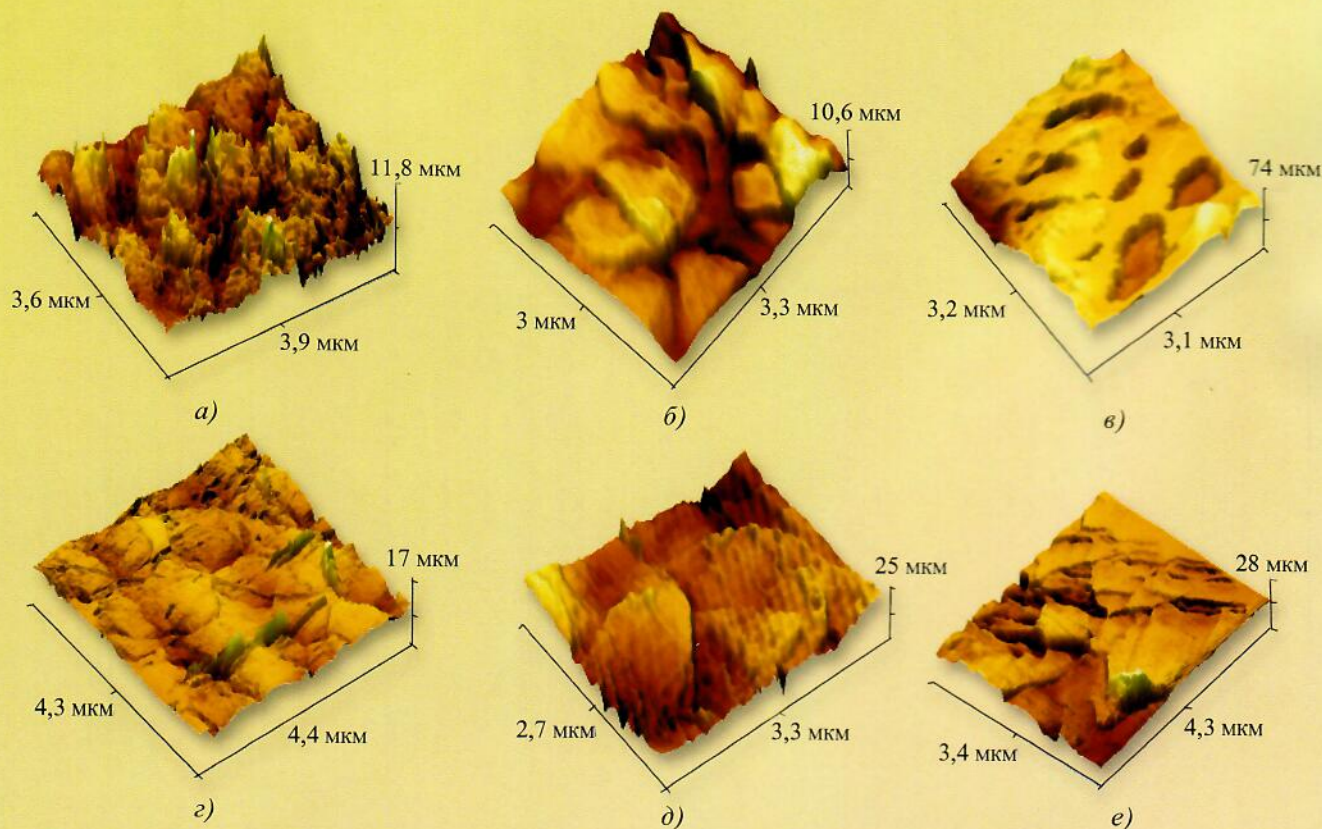


Рис. 4. АСМ-изображения поверхности алюминиевой фольги при изменении температуры и времени отжига: а – 200 °C; б – 400°C; в – 600°C; г – 2 ч; д – 4 ч; е – 6 ч

Рисунки к статье
И. В. Прокофьева,
В. С. Суханова
 «Комплексирование
 магнитоинерциальных
 и спутниковых систем
 навигации для
 систем мониторинга
 параметров движения
 транспорта»

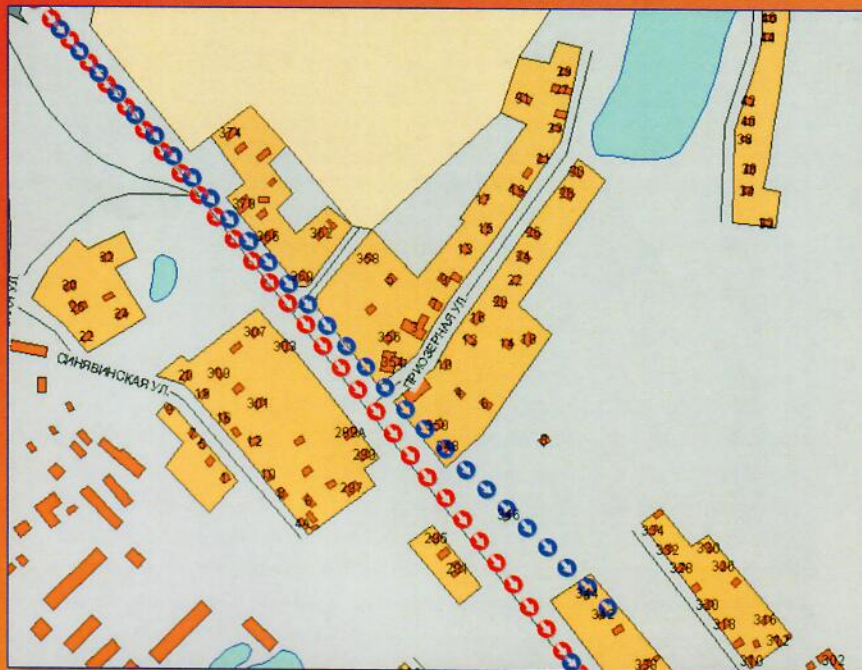


Рис. 1. Компенсация интегральной
 ошибки курсового угла

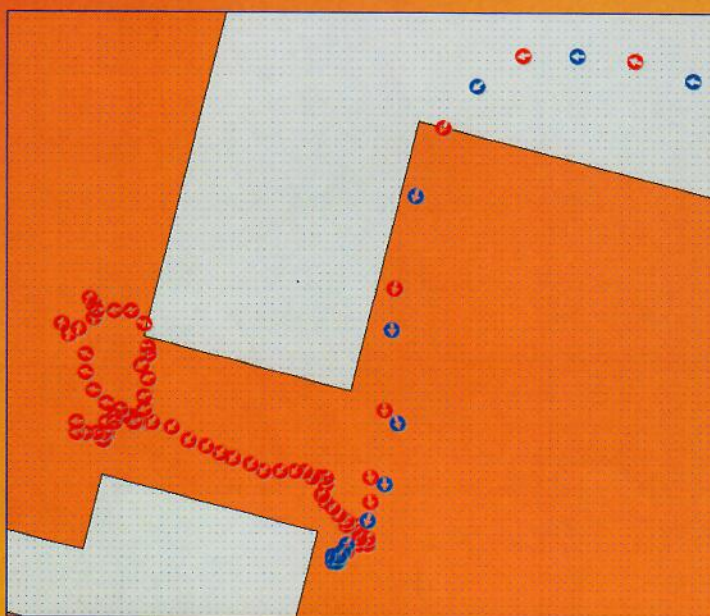


Рис. 2. Компенсация помехи СНС
 в условиях неуверенного приема
 спутниковых данных

Рисунок к статье **С. Кернбаха**
 «Исследование проникающей способности
 светодиодного и лазерного излучения. Часть 1

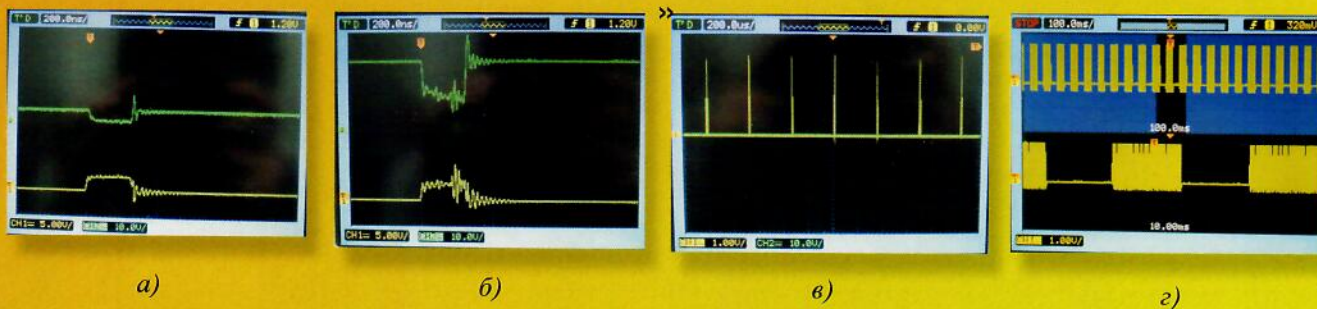


Рис. 4. Примеры первичной (а) и вторичной (г) модуляции сигнала светодиодного генератора. Показаны импульсы напряжения на светодиодах при питающем напряжении 5 В (а) или 29 В (б); горизонтальная развертка (а) и (б) для – 200 нс, в – 200 мкс, г – 100 мс

Рисунки к статье П. П. Мальцева, Д. Л. Гнатюка, Ю. В. Фёдорова,
 А. В. Зуева, Р. Р. Галиева, Н. В. Побойкиной
 «Исследование малосигнальных и шумовых характеристик
 метаморфных транзисторов для монокристаллических интегральных схем
 в крайневысокочастотном диапазоне»

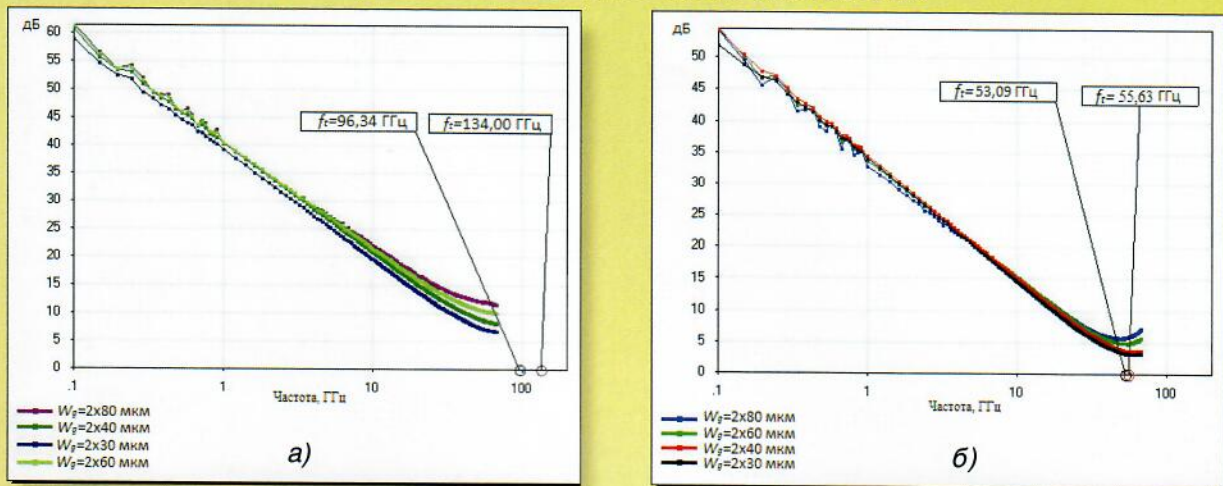


Рис. 3. Частотные зависимости модуля коэффициента передачи по току $|h_{21}|$ для МНЕМТ транзисторов с W_g 2x30, 2x40, 2x60 и 2x80 мкм и с L_g 50 нм (а) и 250 нм (б)

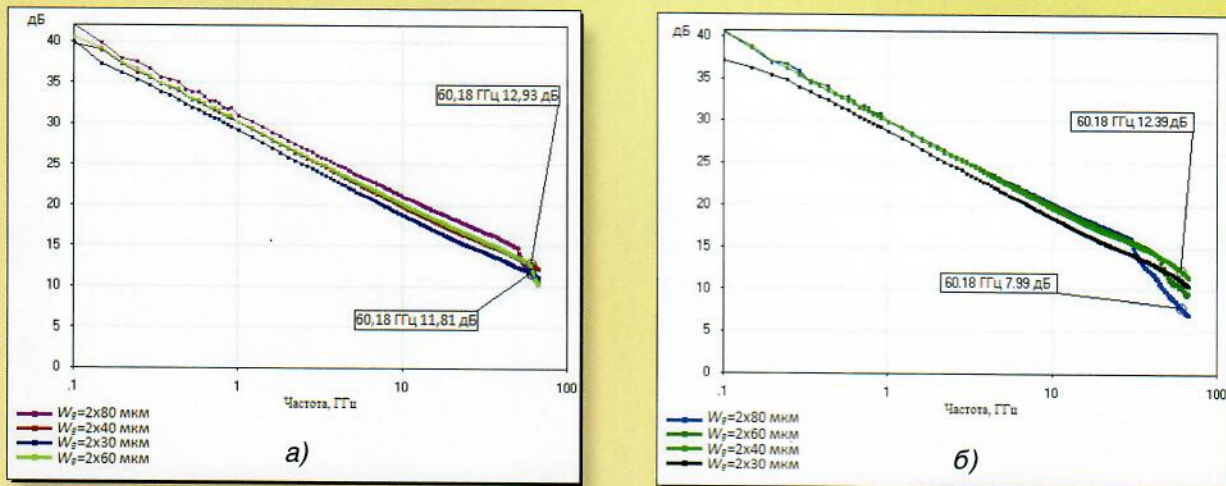


Рис. 4. Частотные зависимости максимально достижимого/стабильного коэффициента усиления по мощности для МНЕМТ транзисторов с W_g 2x30, 2x40, 2x60 и 2x80 мкм и с L_g 50 нм (а) и 250 нм (б)

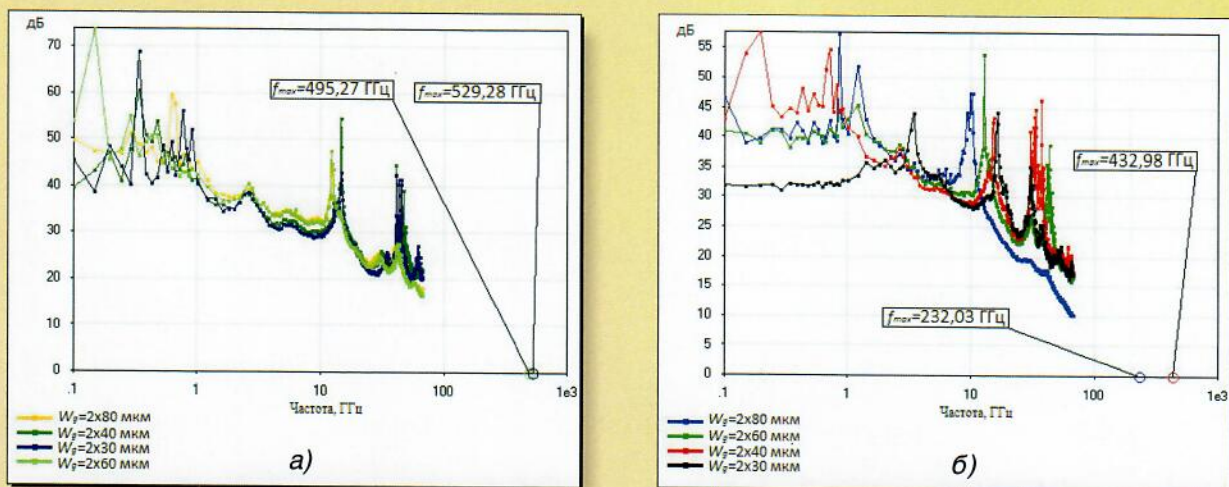


Рис. 5. Частотные зависимости коэффициента усиления Массона для МНЕМТ транзисторов с W_g 2x30, 2x40, 2x60 и 2x80 мкм и с L_g 50 нм (а) и 250 нм (б)